

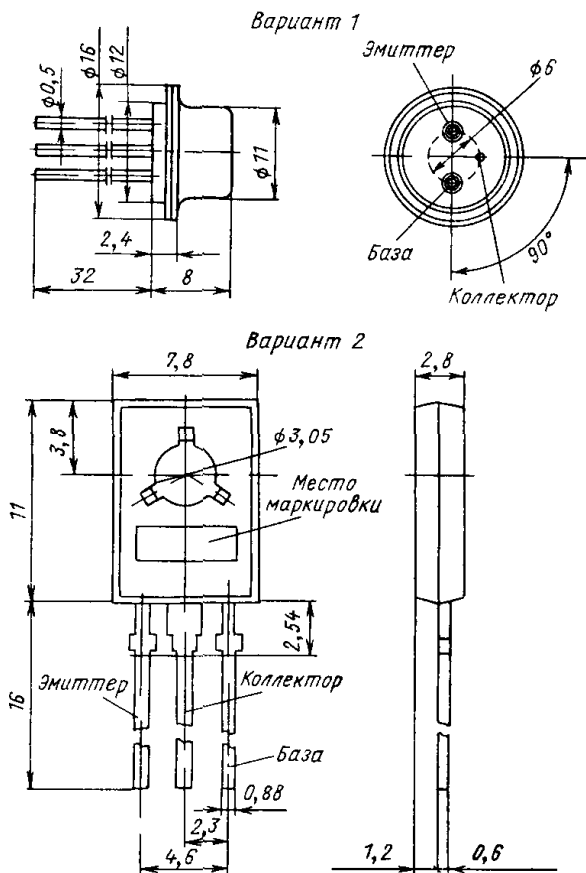
КТ604А, КТ604Б, КТ604АМ, КТ604БМ

Транзисторы кремниевые меза-планарные *n-p-n* универсальные высокочастотные мощные

Предназначены для применения в схемах операционных усилителей, видеусилителей и генераторов разверток

Транзисторы КТ604А, КТ604Б выпускаются в металlostеклянном корпусе (вариант 1), а транзисторы КТ604АМ, КТ604БМ – в пластмассовом корпусе с гибкими выводами (вариант 2) Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора в металlostеклянном корпусе не более 5 г, в пластмассовом не более 1 г



Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Электрические параметры

Напряжения насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 20$ мА, $I_B = 2$ мА не более	8 В
Статистический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 40$ В, $I_Э = 20$ мА	
КТ604А, КТ604АМ	10–40
КТ604Б, КТ604БМ	30–120
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 40$ В, $I_Э = 20$ мА не менее	40 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 40$ В, $f = 2$ МГц не более	7 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, $f = 2$ МГц не более	50 пФ
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 250$ В не более	20 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В не более	50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

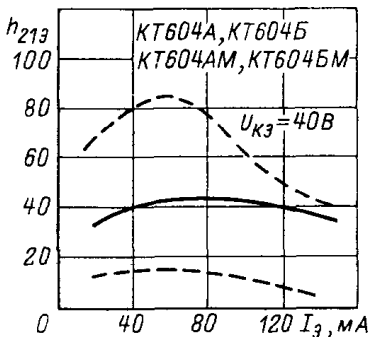
Постоянное напряжение коллектор-база	
при $T \leq 373$ К	300 В
при $T = 423$ К	150 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq 1$ кОм	
при $T \leq 373$ К	250 В
при $T = 423$ К	125 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
при $T \leq 373$ К	5 В
при $T = 423$ К	2,5 В
Постоянный ток коллектора	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
без теплоотвода	
при $T < 298$ К	0,8 Вт
при $T = 373$ К	0,33 Вт
с теплоотводом	
при $T_k \leq 298$ К	3 Вт
при $T_k = 373$ К	1,25 Вт
Температура перехода	423 К
Тепловое сопротивление	
переход-корпус	40 К/Вт
переход-окружающая среда	150 К/Вт
Температура окружающей среды и корпуса	От 233 до 373 К

Примечание При монтаже допускается пайка выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса Пайку следует производить паяльником в течение не более 10 с, температура пайки не должна превышать 533 К Необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки

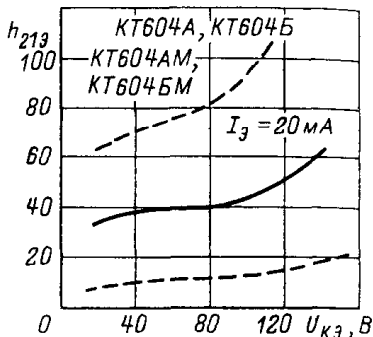
Материал взят из источника:

Для транзисторов в металлостеклянном корпусе изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 3 мм, при этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность вывода между местом изгиба и стеклянным изолятором.

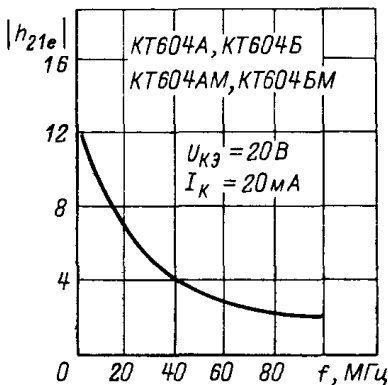
Для транзисторов в пластмассовом корпусе изгиб выводов допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса транзистора, и на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба не менее 1,5 мм



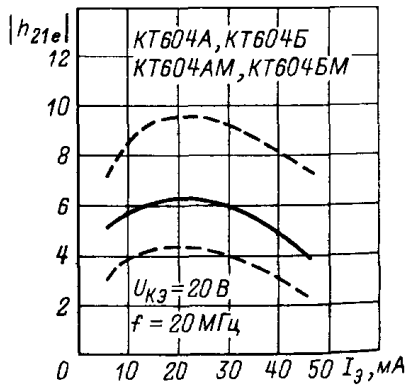
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер

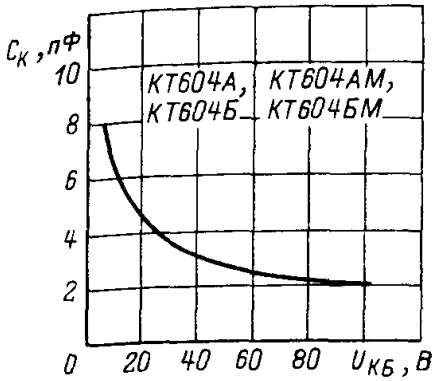


Зависимость модуля коэффициента передачи тока от частоты

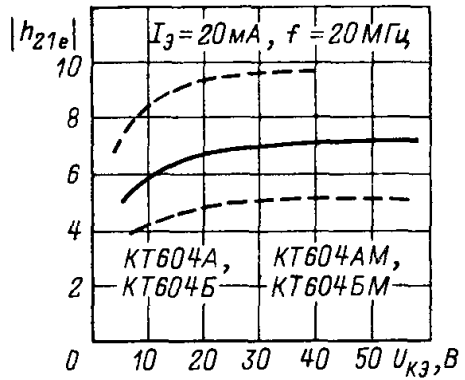


Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Материал взят из источника:



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Зона возможных положений зависимости модуля коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985